

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники.

Председателю диссертационного
совета Д212.268.01 на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, д.т.н.,
профессору Пустынскому И.Н.

Уважаемый Иван Николаевич!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации Гончаровой Юлии Сергеевны «Тепловой режим полупроводниковых источников света при ускоренных испытаниях на надежность и долговечность» по специальности 05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

Профессор кафедры естественнонаучного образования
ЮТИ ТПУ

д.т.н, профессор,
А.В. Градобоев



Ученый секретарь НИ ТПУ



О.А. Ананьева

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Гончаровой Юлии Сергеевны «Тепловой режим полупроводниковых источников света при ускоренных испытаниях на надежность и долговечность» по специальности 05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Градобоев Александр Васильевич
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 01.04.10
Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
Основное место работы	
Должность	Профессор
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	Кафедра естественнонаучного образования
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	652057, г. Юрга, Кемеровская обл., ул. Ленинградская, 26 http://uti.tpu.ru/ 8 (384-51) 7-77-67
Публикации по специальности 05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)	
Градобоев А.В., Рубанов П.В., Седнев В.В. Влияния температуры на стойкость светодиодов ИК-диапазона к облучению гамма-квантами ^{60}Co // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. - 2016. - № 1. - С. 37-41.	
Рубанов П.В., Градобоев А.В. Неаддитивность деградации светодиодов на основе гетероструктур AlGaAs при комбинированном облучении быстрыми нейтронами и электронами // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. - 2014. - № 2. - С. 42-44.	
Рубанов П.В., Градобоев А.В. Деградация светодиодов на основе	

гетероструктур AlGaAs при комбинированном облучении быстрыми нейтронами // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2013. - Т. 56. - № 1-2. - С. 49-52.

Градобоев А.В. Асанов И.А., Салчак Я.А. Влияние облучения быстрыми нейтронами на надежность светодиодов ИК-диапазона // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2013. - Т. 56. - № 11-3. - С. 111-115.

Солдаткин В.С., Вилисов А.А., Градобоев А.В., Асанов И.А., Тепляков К.В. Стойкость GaN-светодиодов к облучению нейтронами // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2012. - Т. 55. - № 9-2. - С. 290-291.

Официальный оппонент А.В. Градобоев / А.В. Градобоев/

Верно: Ученый секретарь НИИПН О.А. Ананьина /О.А. Ананьина/

21 сентября 2016 года.

